

METHOD FOR FLATTENING RESIST

Patent number: JP5061206

Publication date: 1993-03-12

Inventor: UESUGI TAKESHI

Applicant: OKI ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international: G03F7/38; H01L21/027; G03F7/38; H01L21/02; (IPC1-7): G03F7/38; H01L21/027

- european:

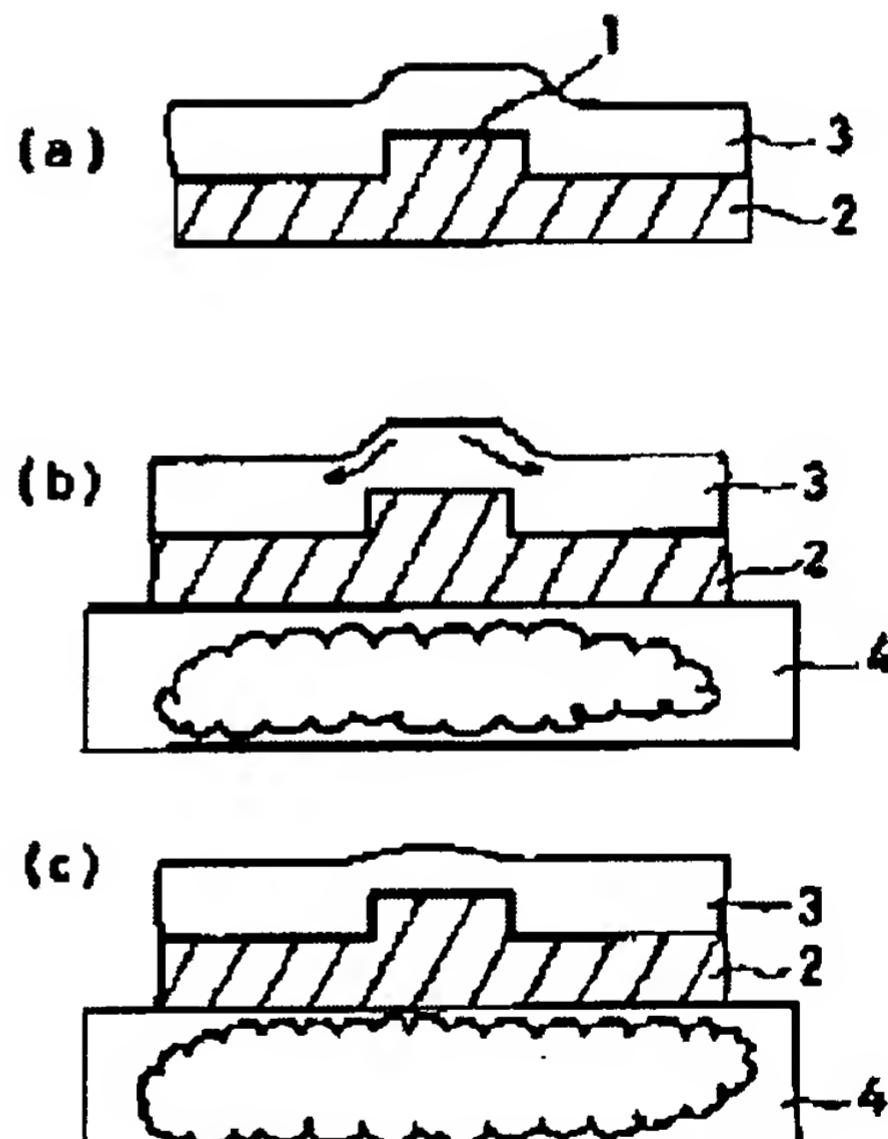
Application number: JP19910219705 19910830

Priority number(s): JP19910219705 19910830

[Report a data error here](#)

Abstract of JP5061206

PURPOSE: To obtain excellent flatness and to prevent a processing atmosphere from being polluted by the generated gases from a resist prep'd. by dissolving specific cresol novolak into ethyl cellosolve acetate in a high-temp. processing stage after formation of the resist by applying the above-mentioned resist on a substrate and processing the substrate by two stages of baking. **CONSTITUTION:** The semiconductor substrate 2 having ruggedness is prep'd. and the resist 3 prep'd. by dissolving the o-cresol novolak having 700 to 17000 mol.wt. into the ethyl cellosolve acetate is applied on this substrate 2. The substrate 2 coated with the resist 3 is then baked at 180 to 220 deg.C. Further, the resist 3 subjected to the 1st baking stage is baked at 270 to 300 deg.C. The 1st baking to be executed at 180 to 220 deg.C in such a manner acts to flatten the applied resist 3 and the 2nd baking to be executed at 270 to 300 deg.C exists in the resist and acts the expel the gases generated by thermal decomposition, etc., in a heating stage.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-61206

(43)公開日 平成5年(1993)3月12日

(51) Int.Cl. ⁵ G 03 F 7/38 H 01 L 21/027	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
		7124-2H		
		7352-4M	H 01 L 21/30	3 6 1 X
		7352-4M		3 6 1 B
		7352-4M		3 6 1 G

審査請求 未請求 請求項の数1(全7頁)

(21)出願番号 特願平3-219705

(22)出願日 平成3年(1991)8月30日

(71)出願人 000000295

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72)発明者 上杉 肇

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気
工業株式会社内

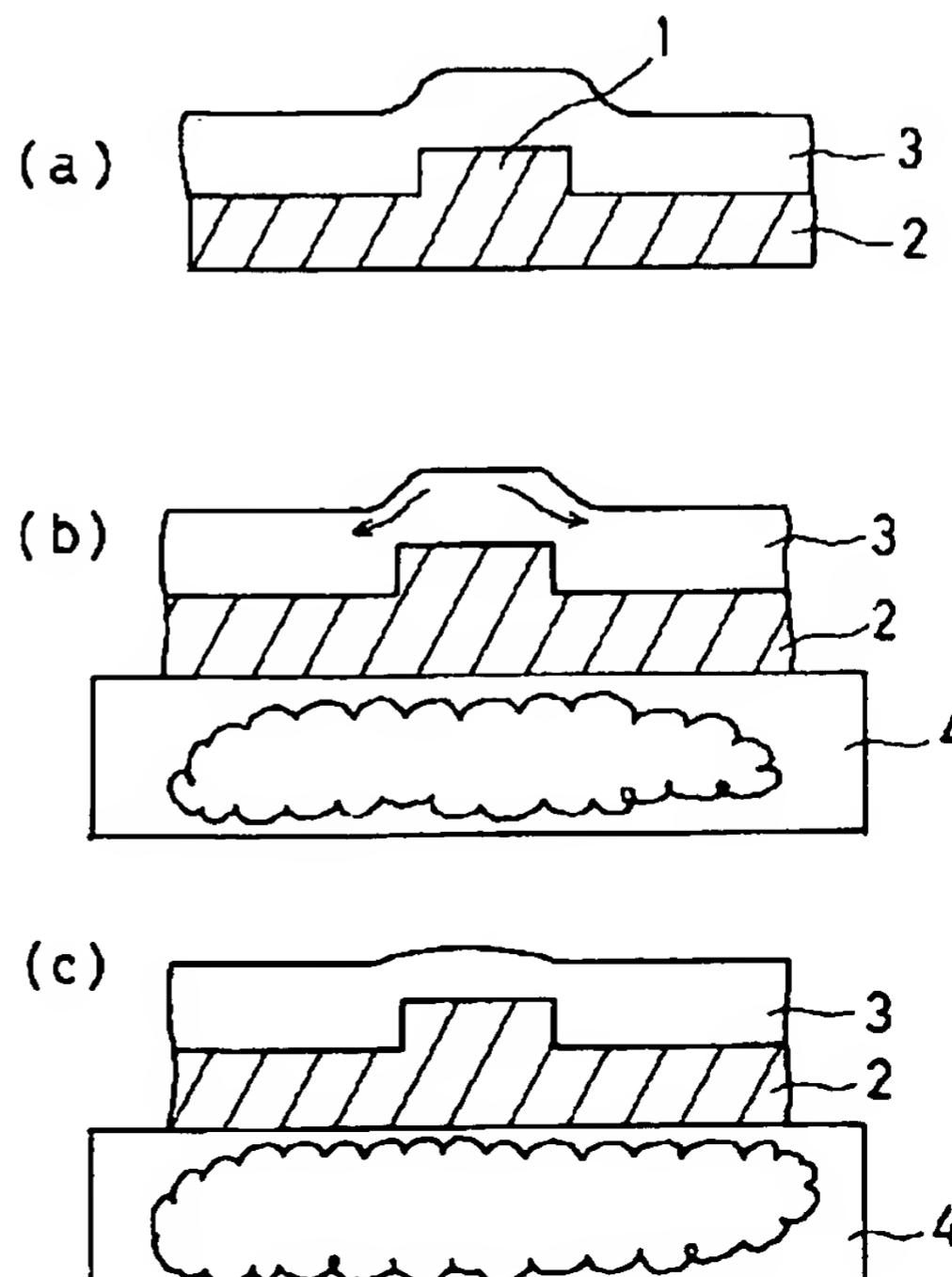
(74)代理人 弁理士 鈴木 敏明

(54)【発明の名称】 レジストの平坦化方法

(57)【要約】

【目的】 平坦化性にすぐれ、レジスト形成後の高温処理工程においても、レジストからの発生ガスによって処理雰囲気を汚染しないレジストを提供することにある。

【構成】 分子量700～1700のo-クレゾールノボラックをエチルセルソルブアセテートに溶解したレジスト3を塗布し、180～220℃でペークし、さらに270～300℃でペークする2段階ペークを施す。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 凹凸を有する基板を準備する工程と、この基板上に分子量700～1700のo-クレゾールノボラックをエチルセルソルブアセテートに溶解したレジストを塗布する工程と、前記レジストを塗布した基板を180℃～220℃でピークする第1のピーク工程と、この第1のピーク工程が施された前記レジストを塗布した基板を270℃～300℃でピークする第2のピーク工程とを有することを特徴とするレジストの平坦化方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 この発明はレジストの平坦化方法に関し、詳しくはo-クレゾールノボラック（以下o-CNという）をエチルセルソルブアセテート（以下ECAという）に溶解したレジストを用いた平坦化方法に関するものである。

【0002】

【従来技術】 o-CNをECAに溶解したレジストによる平坦化方法は発明協会公開技報No. 90-12944に開示されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、この開示内容は単にo-CNをECAに溶解したレジストの利用についてのみであり、このままでは後の高温ピーク工程でECAもしくはその熱分解による物質の一部がガスとして発生し、プロセスの環境を悪化してしまうという問題があった。

【0004】

【課題を解決するための手段】 上記問題点を解決するため、この発明では凹凸を有する基板上に分子量700～1700のo-クレゾールノボラックをエチルセルソルブアセテートに溶解したレジストを塗布する工程と、このレジストを塗布した基板を180℃～220℃でピークする第1のピーク工程と、この第1のピーク工程が施された基板を270℃～300℃でピークする第2のピーク工程とを有するレジストの平坦化方法を提供する。

【0005】

【作用】 700～1700の分子量のo-クレゾールノボラックは平坦性の高いレジスト材に寄与する。180℃～220℃で行なう第1のピークは、塗布したレジストを平坦化させるよう作用する。270℃～300℃で行なう第2のピークはレジスト中に存在し、加熱工程で熱分解等によって発生するガスを追い出すよう作用する。

【0006】

【実施例】 図1 (a)～(c)はこの発明の実施例を示す断面図である。

【0007】 まず、図1 (a)に示すようにパターン幅

50 μm、段差1.0 μmのパターン1を有する半導体基板2上に分子量1000程度の低分子量からなるo-CNをECAに溶解したレジスト3を1.5 μm程度回転塗布する。ここで、分子量を1000程度としたのは次のような実験結果に基いている。

【0008】 図2はo-CNの分子量に対する平坦化特性を示すグラフで、この実験は初期段差1.0 μm、パターン幅80 μm以下の凹凸を有する基板上に分子量が1000, 2000, 3000のo-CNを1.8 μm回転塗布後、200℃で5分ピークを行なった後の表面段差を測定した。この図からわかるように、o-CNの分子量は小さい程よく、分子量1000のo-CNではパターン幅40 μm程度の凹凸段差を約0.2 μmの表面段差で被覆している。ここで、分子量は500程度と小さすぎるピーク時の基板との密着性が悪くなったり、レジスト表面がラフになったりするので、700～1700程度が良いと考えられる。

【0009】 次に、図1 (b)に示すように、レジスト3をホットプレート4で200℃、3分の第1のピークを行なう。この第1のピーク温度を200℃としたのは次のような実験結果に基いている。

【0010】 図3はピーク温度に対する平坦化特性を示すグラフで、この実験は初期段差1.0 μmで、パターン幅15 μm, 32 μm, 70 μmからなる凹凸を有する基板にECAに溶解した分子量1000のo-CNを1.5 μm回転塗布後、ピーク温度を変化させて1分間ピークした後の表面段差を測定した。図3からわかるように、どのようなパターン幅の凹凸でも、180℃～220℃で良好な平坦性が得られる。これは、230℃以上ではo-CNの熱溶融性よりも熱架橋性が優勢になるためと考えられる。

【0011】 さて、第1のピーク後、レジスト3は図1 (c)に示すように平坦化され、その表面段差は0.2 μmとなる。この平坦化されたレジスト3を300℃で1分間第2のピークを行なう。この第2のピークは第1のピーク後残っているECAやECAの熱分解した物質、又はo-CNの側鎖の-OH, -CH₃などの未反応成分の熱分解による物質がガスとして発生するのを防ぐために行なうものである。

【0012】 この第2のピークの効果を確かめるために図4、図5に示す実験を行なった。

【0013】 図4はTG-MS法によるアウトガス（レジストから出たガス）の分析結果を示す図である。図4に示す実験は分子量1000のo-CNをECAに溶解したレジストを基板に塗布し、50℃から10℃/分の昇温速度で400℃まで昇温させた時のレジストからの発生ガスをECAに注目してガス強度を測定したものである。図4のaは分子量78のベンゼン、bは分子量77のC₆H₅、cは分子量72の物質、dは分子量59の物質、eは分子量43の物質、fは分子量31の物

3

質, g は分子量 29 の物質, h は分子量 15 の CH_3 , i は分子量 18 の水を示している。

【0014】図4のc, d, e, f, g, h はECAから熱分解等で発生したものと考えられ、ECAの沸点である 156°C 近傍で強度が最大となり、250°C ぐらいまで発生が認められる。逆に図4の a, b, i は o-CN から発生したガスと考えられ、350°C 以上で発生が認められる。従って、第2のピークは o-CN が分解せず、かつ、ECAからのガスを完全に追い出してしまう温度である。270°C ~ 300°C で行なうのが適当と考えられる。

【0015】図5は2段階ピークによる平坦化性を示す図である。図5の実験では、ECAに溶解した o-CN を200°C 3分でピークし、(第1のピーク) 平坦化させた後、300°C 1分でピークした(第2のピーク) ものと、300°C で1分ピークしたものとを、パターン幅に対して表面段差を測定した。ここで、両者のレジストの膜厚は 1.8 μm, 初期段差は 1.0 μm である。

【0016】図5からわかるように2段階ピークしたものは、ピーク1回しかしないものよりも良好な平坦性を示しており、図2で示した平坦化特性とほぼ同じことがわかる。

【0017】以上2段階ピークについて詳細に述べたが、レジスト塗布工程後に高温処理工程が存在しない場

4

合は第2のピークを省略することも可能であることはいうまでもない。

【0018】

【発明の効果】以上述べたように、この発明によれば分子量 700 ~ 1700 の o-クレゾールノボラック をエチルセルソルブアセテートに溶解したレジストを2段階ピークによって処理したため、平坦度の優れたレジストが得られ、また、後の高温処理工程においても処理雰囲気をレジストからの発生ガス等で汚染することもない。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) ~ (c) はこの発明の実施例を示す図

【図2】 o-クレゾールノボラック の分子量に対する平坦化特性を示す図

【図3】 ピーク温度に対する平坦化特性を示す図

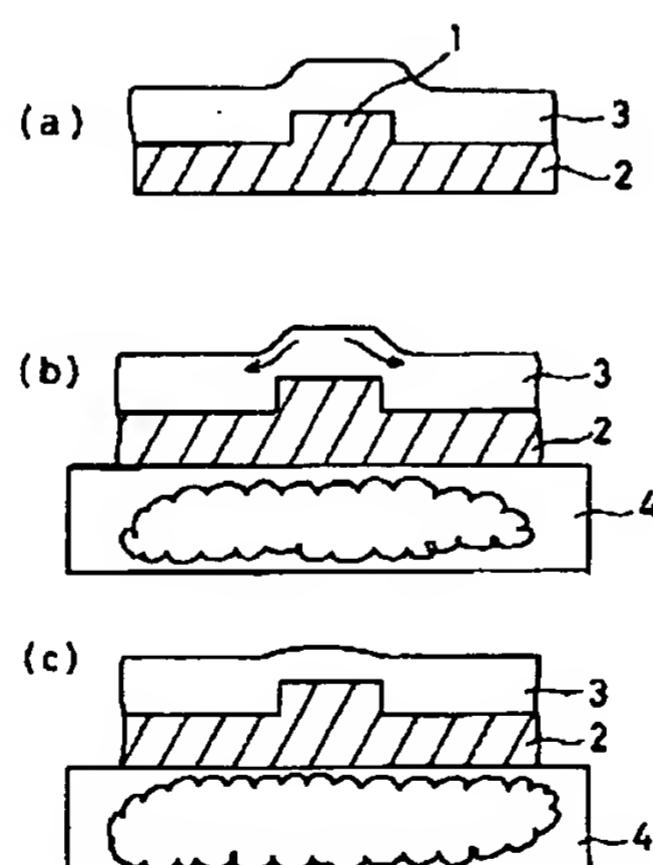
【図4】 TG-MS 法によるレジストのアウトガス強度を温度に対して測定した図

【図5】 2段階ピークと1段階ピークとの比較を示す図である。

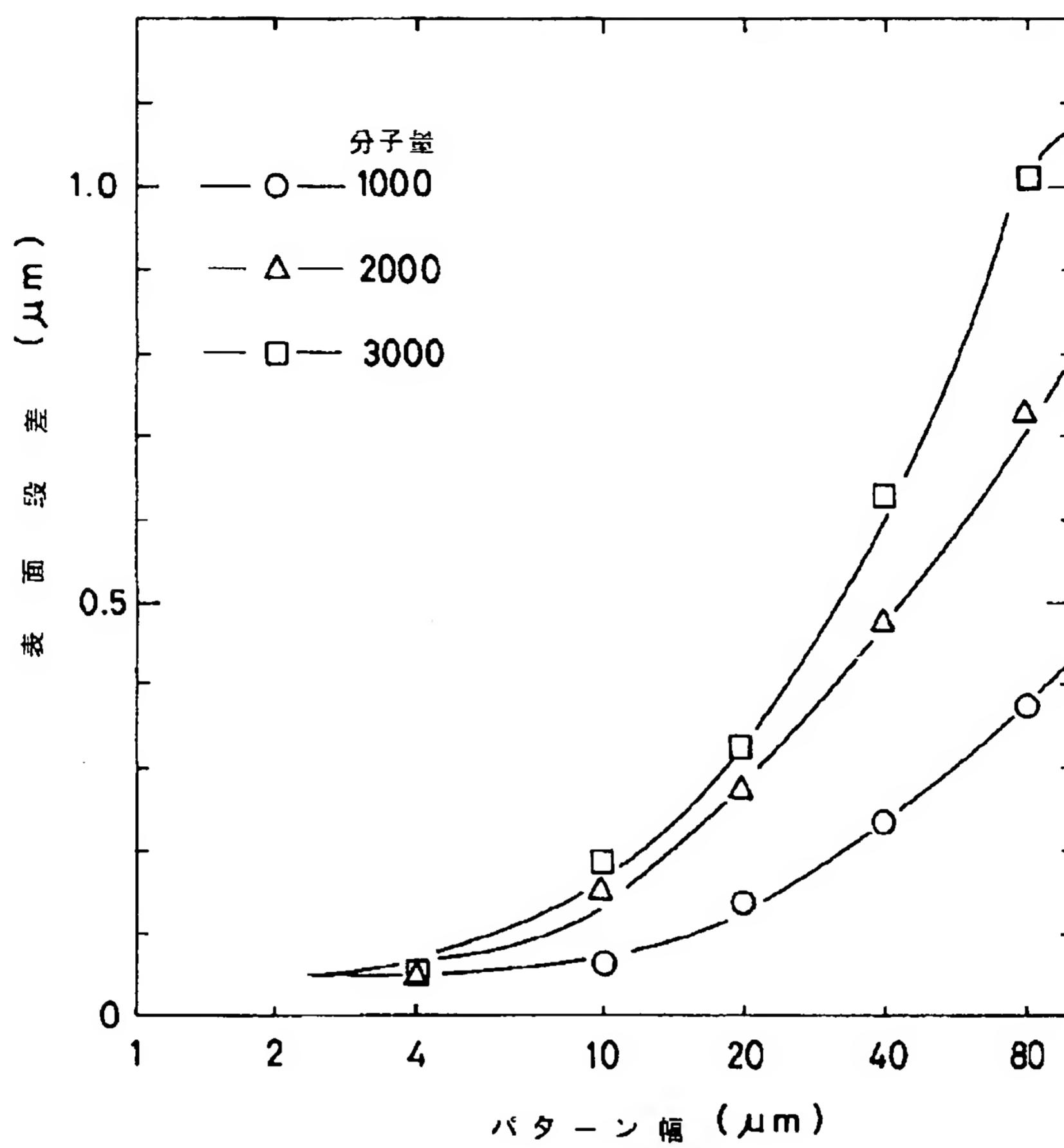
【符号の説明】

20 1 段差
2 基板
3 レジスト
4 ホットプレート

【図1】

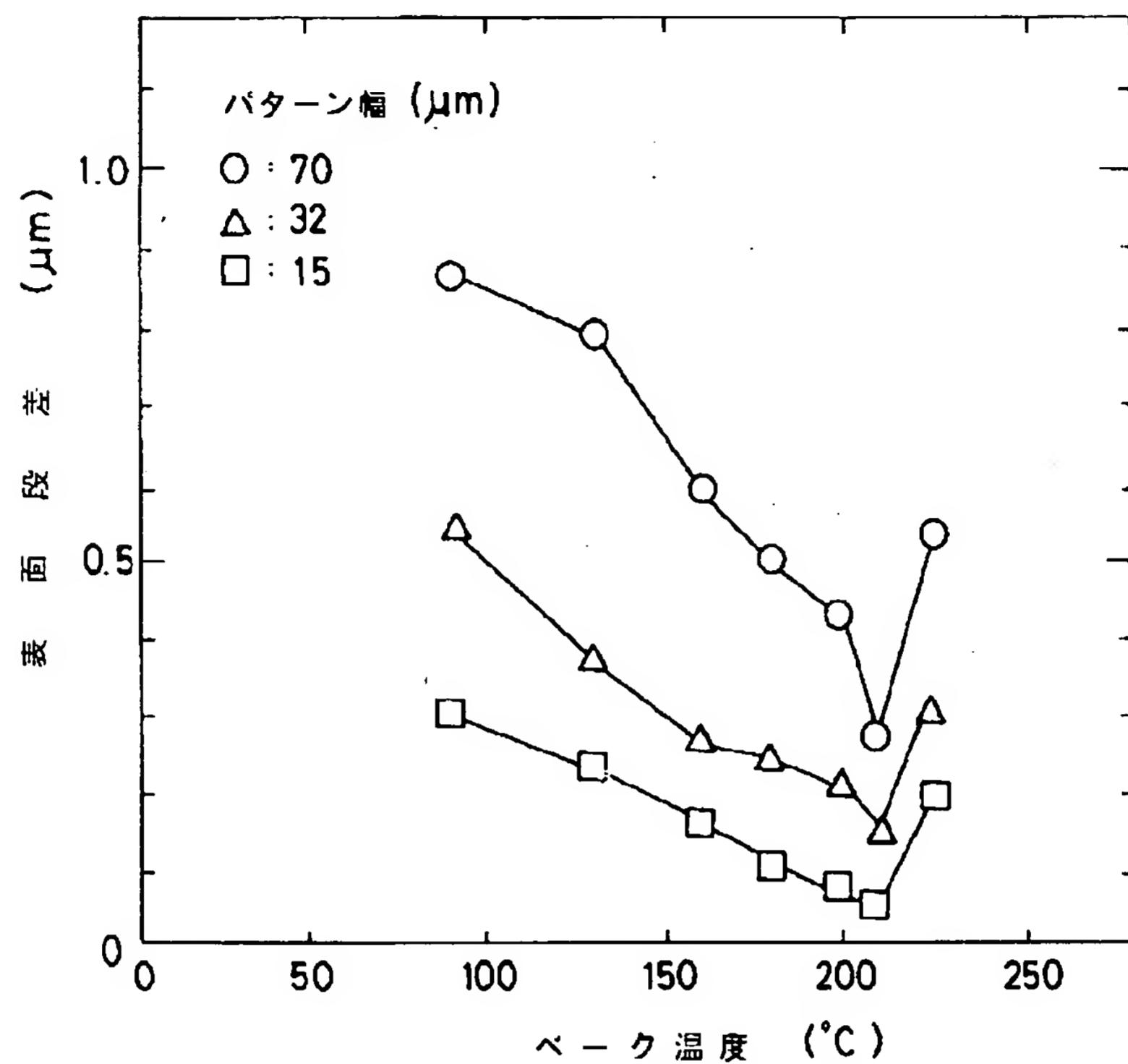


【図2】



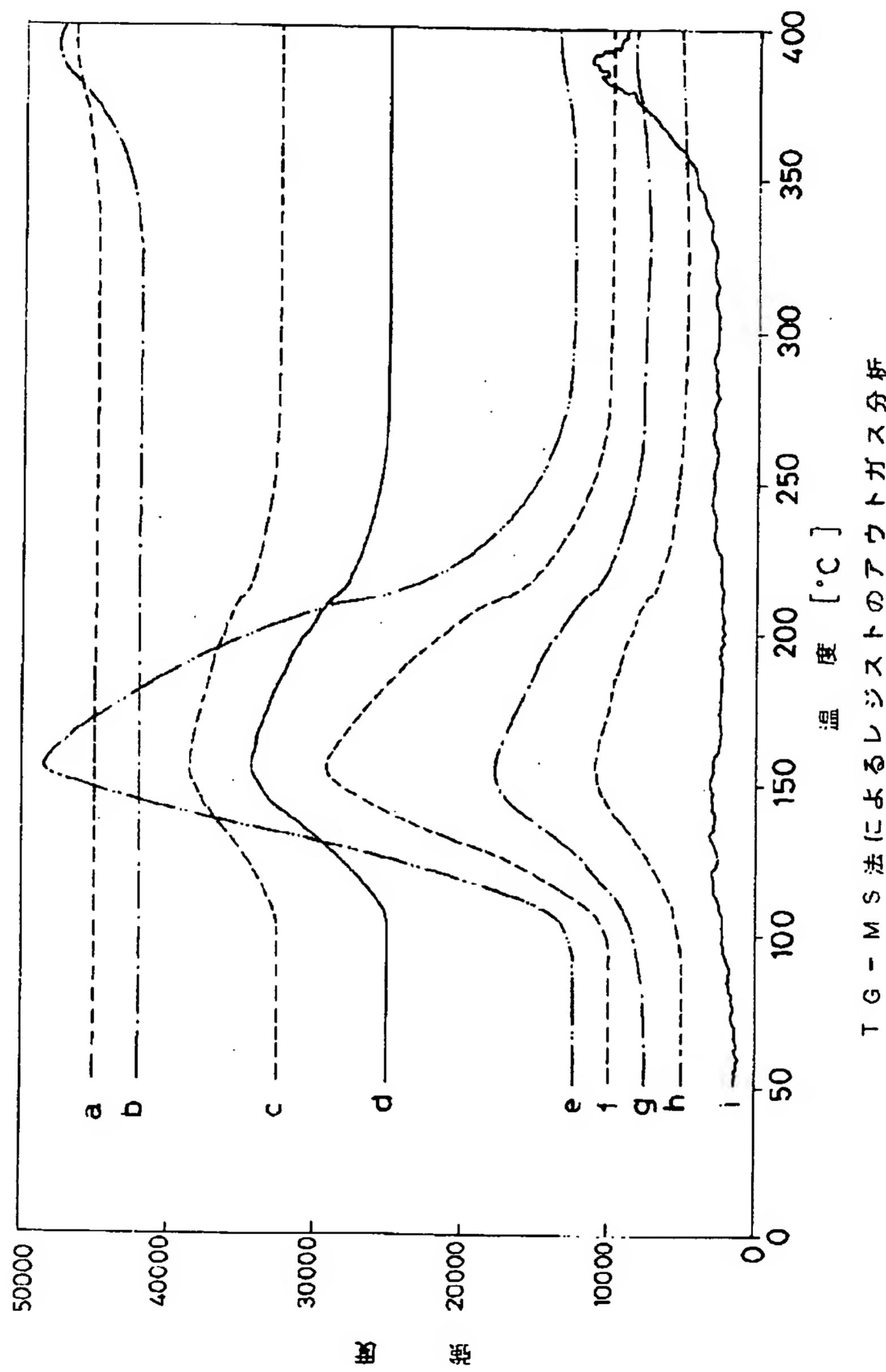
O - C N の分子量に対する平坦化特性

【図3】



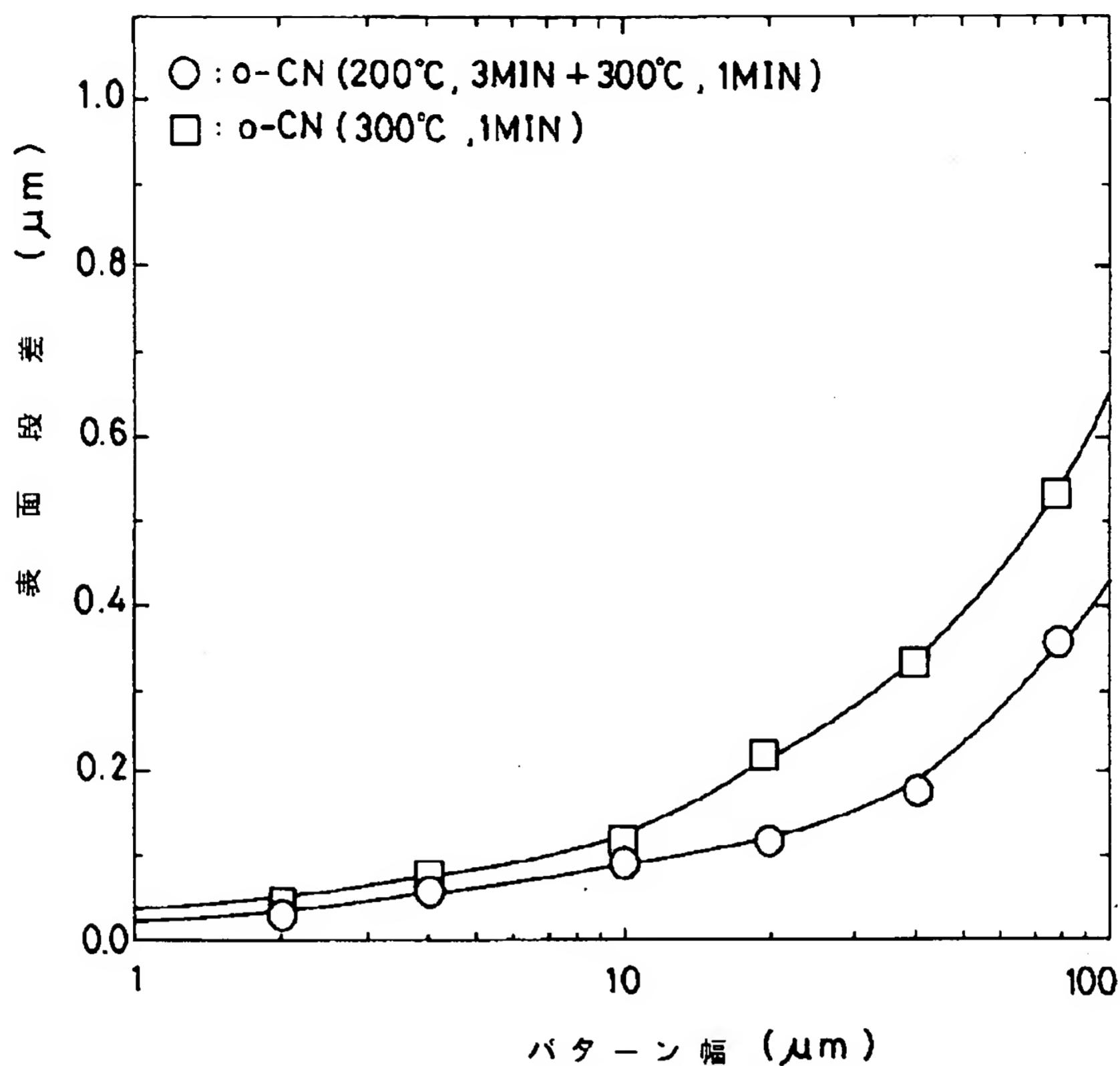
ピーク温度に対する平坦化特性

【図4】



TG-MS法によるレジストのアカトガス分析

【図5】



○ - CNにおける平坦化特性の 2段階ピーク法による効果